

ПЛАН на выполнение НИР "Исследование фотоэлектрических свойств тонких пленок порфиринов и гетероструктур на их основе"

1. Формирование электрических контактов (для сэндвичевой либо планарной геометрии ячейки) к тонким плёнкам порфиринов осаждением слоёв металлов через теневою маску в высоком вакууме.
2. Оценочные измерения электросопротивления плёнок порфиринов в атмосферах различного состава в темноте и при освещении.
3. Измерение вольтамперных характеристик в высокочистой контролируемой атмосфере, в условиях различной освещенности, скорости и интервала развёртки.

Список оборудования и перечень услуг ЦКП ИФМ РАН для выполнения НИР "Исследование фотоэлектрических свойств тонких пленок порфиринов и гетероструктур на их основе"

п/п	Наименование используемого Оборудования ЦКП ИФМ РАН	Пункт из перечня услуг(работ), указанного на сайте	Наименование работы	Стоимость работ 1час (в руб)	Расчетное время работ (в час)	Цена работы (в руб)
1	Установка для измерения вольт-амперных характеристик	п.44	Измерение вольтамперных характеристик тонкопленочных структур в контролируемой инертной атмосфере (Ar) по H ₂ O, O ₂ <1 ppm	4 000,00	111,0	444 000,00
2	Установка для термического напыления металлов, диэлектриков, органических полупроводников	п.45	Нанесение тонкопленочных и многослойных покрытий с использованием установки термического напыления	7 000,00	108,0	756 000,00
	ВСЕГО стоимость НИР				219,0	1 200 000,00

Зам.директора ИФМ РАН _____ Е.А.Девятайкина

Нач.ПЭО ИФМ РАН _____ А.И.Хусаинова

Руководитель НИР, С.Н.С, к.х.н. _____ Г.Л.Пахомов